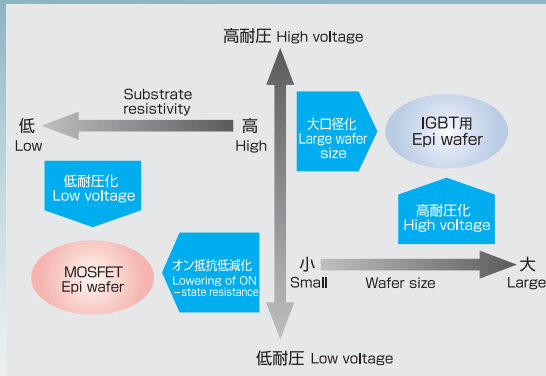


エピタキシャルウェーハ

Epitaxial Wafers

コンセプト Concept

オン抵抗の低減化と高耐圧化
Low ON-state resistance and high voltage



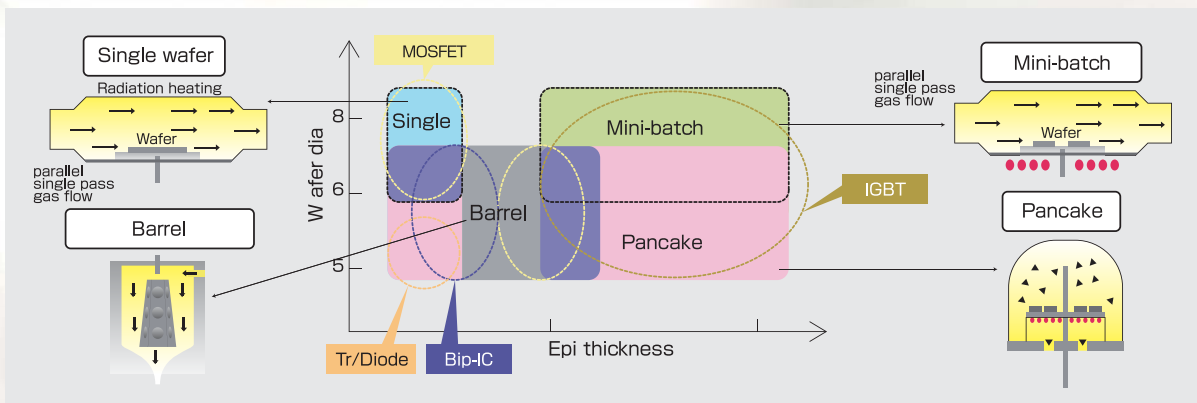
代表的製品・特長 Features

多様化するお客様のニーズに応える製品ラインナップ
Epi wafer products corresponding to customers' various needs

構造 Structure	直径(mm) Diameter	エピ厚(μm) Epitaxial layer thickness	エピ抵抗率(Ωcm) Epitaxial layer resistivity	用途 Usage
N N+ P+ As, Sb	100~200	2~150	0.02~150	SBD MOSFET
P P+ ←B	100~200	2~150	0.2~150	PNP Tr
N P	100~200	~5	~5	J-FET
N N+ P+	125~200	30~150 (N+:5~30)	30~180 (N+:0.01~0.1)	IGBT
N N+ P	125~150	2~70	0.2~50	Bip IC

中核技術 Core technology

様々な用途・サイズに対応可能なエピ装置技術
Epitaxializing technology for Epi wafers with various size and applications



今後の方向・計画 Future direction and plan

先端製品への展開 Evolution of our leading products

